

旗舰型离子色谱

FEI COMPANY™
TOOLS FOR NANOTECH

岛津
SHIMADZU

赵彦桥 天津 河北工业大学信息功能材料研究所 300130

韩彦辉 天津 河北工业大学信息功能材料研究所 300130

杨燕萍 天津 河北工业大学信息功能材料研究所 300130

郝秋艳 天津 河北工业大学信息功能材料研究所 300130

刘彩池 天津 河北工业大学信息功能材料研究所 300130

摘要：采用PL Mapping技术，检测6英寸SI-GaAs晶片的均匀性，从而得到样品中的缺陷分布状况。本文主要通过光荧光谱获得样品表面和内部丰富信息，利用光谱图中颜色的不同来分析样品缺陷的不均匀分布等特点；对比样品局部发光强度信号和发光峰位的变化曲线图及化学腐蚀图片，进一步讨论由于缺陷而造成的样品均匀性的变化。

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载至本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 Acrobat Reader [[下载阅读器](#)]

The defects distribution of SI-GaAs wafer using PL Mapping technique

300130

300130

300130

300130

300130

Abstract: In this paper, the defects distribution of SI-GaAs wafer was studied using PL Mapping technique in detail. The experiment results showed the information about the sample's surface and inner analyzed by the spectrum. We analyzed the non-uniform defects distribution according to different colors in the spectral map. By comparing PL Mapping with line profile of peak int and chemical etching pictures, we discussed uniformity change of the sample quality due to the existential defects.

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]